

## Samsung Electronics представляет первый на рынке модуль LPDDR4 DRAM объемом 8 Гб

24.10.2016

Компания Samsung Electronics представила первый на рынке мобильный модуль DRAM с низким потреблением мощности и двукратной скоростью передачи данных (low power, double data rate 4 – LPDDR4) объемом 8 Гб. Ожидается, что новое решение существенно улучшит работу мобильных устройствами, оснащенных большими Ultra HD дисплеями. В модуль DRAM 8 Гб установлены четыре новейших 16-гигабитных LPDDR4 чипа памяти, изготовленных по 10-нм технологическому процессу.

«Запуск нового мощного мобильного модуля DRAM 8 Гб приведет к появлению более производительных флагманских мобильных устройств нового поколения по всему миру, – сказал Ю Сон Чой, исполнительный вице-президент подразделения маркетинга и продаж устройств памяти Samsung Electronics. – Мы продолжим создавать высококачественные передовые решения для хранения данных, которые отвечают растущим потребностям самых современных устройств с такими функциями, как сдвоенная камера, видео в разрешении 4K UHD и технологии виртуальной реальности».

Скорость передачи нового LPDDR4 8 Гб достигает 4266 Мбит/с, что вдвое выше, чем показатели DDR4 DRAM для ПК, обычно составляющие примерно 2133 Мбит/с. При условии, что ширина шины памяти составляет 64 бит (x64), это гарантирует передачу данных со скоростью 34 Гб в секунду.

Несмотря на то что DRAM емкостью 8 Гб сегодня используется во многих ультратонких ноутбуках, новый модуль Samsung 8GB LPDDR4 даст мобильным устройствам нового поколения все преимущества максимальной пропускной способности. Так, оснащение решением 8 Гб LPDDR4 планшетов обеспечит более плавное воспроизведение 4K UHD видео – популярную возможность многих ПК премиального класса.

Благодаря применению новейшего техпроцесса 10-нм и высокой энергоэффективности, Samsung 8 Гб LPDDR4 DRAM более эффективно расходует заряд аккумулятора устройств. Это позволило удвоить вместимость микросхем модуля 4 Гб DRAM класса 20-нм и, в то же время, сохранить уровень потребления энергии.

Габариты 8 Гб LPDDR4 составляют менее 15x15x1 мм, что отвечает требованиям к размерам большинства современных ультратонких мобильных устройств. В зависимости от предпочтений производителя комплект DRAM толщиной менее 1 мм можно использовать вместе с универсальным флеш-накопителем или мобильным процессором, что позволяет экономить пространство печатной платы устройства.

В августе 2015 года Samsung представила первое на рынке решение LPDDR4 DRAM емкостью 12 Гб по техпроцессу 20-нм. Период разработки нового 16 Гб LPDDR4 DRAM решения по техпроцессу 10-нм, а также 8 Гб LPDDR4 DRAM, составил всего 14 месяцев.

Samsung продолжит расширять линейку продуктов DRAM по техпроцессу 10-нм. Компания уже создает производственную линию DRAM 10-нм и планирует начать использовать эту технологию в других системах, что позволит удовлетворить постоянно увеличивающимся спрос на передовые DRAM высокой плотности.

